

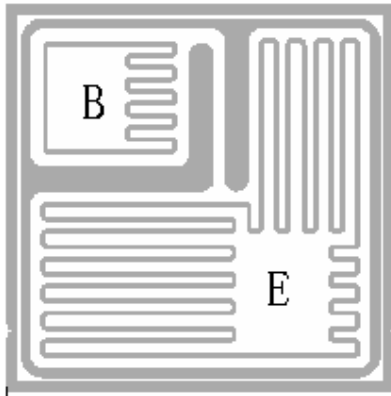
ND1.65

硅 NPN 外延平面晶体管芯片 (4 ")

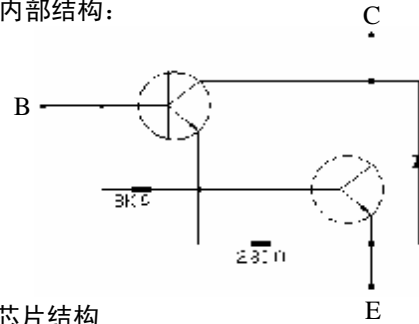
■用途

- * 电源调整管
- * 音频功率放大器
- * 其他电子电路

■芯片示意图



■内部结构:



■芯片结构

芯片尺寸	1650 μ m × 1650 μ m
压焊区尺寸	基区 350 μ m × 430 μ m 发射区 380 μ m × 500 μ m
锯片槽宽度	90 μ m
芯片厚度	240 ± 10 μ m
金属层	正面: Al 3.1 ± 0.4 μ m 背面: Ag 1.4 ± 0.2 μ m

■电特性(Ta=25℃)

参数名称	符号	测试条件	典型值	最小值	最大值	单位
集电极--基极击穿电压	BV_{CBO}	$I_C=0.1mA, I_E=0$	250	150		V
集电极--发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C=10mA, I_B=0$	150	100		V
集电极--发射极维持电压	$V_{CEO(sus)}$	$I_C=30mA, I_B=0$		100		V
发射极--基极击穿电压	BV_{EBO}	$I_B=2.5mA, I_C=0$		10		V
集电极--基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=100V, I_E=0$			1	μ A
集电极-发射极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE}=100V, I_B=0$			2	μ A
发射极--基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=10V, I_C=0$	1.3		2.5	mA
直流电流增益	h_{FE1}	$V_{CE}=3V, I_C=0.5A$		850	15000	
直流电流增益	h_{FE2}	$V_{CE}=3V, I_C=2A$	4000	2000	15000	
集电极--发射极饱和电压	V_{CES}	$I_C=3A, I_B=12mA$	1.3		1.8	V

* $V_{CEO(sus)}$: 脉宽≤300 μ s, 占空比≤2% (TO—220)